

新規チタン酸バリウム系強誘電体

秋重幸邦

(受取日:2006年6月10日,受理日:2006年7月5日)

New Ferroelectrics in Barium Titanate System

Yukikuni Akishige

(Received June 10, 2006; Accepted July 5, 2006)

Barium titanate single crystals doped with KF ($Ba_{1-x}K_xTiO_{3-x}F_x$ with $x \le 0.1$) have been successfully grown; the ferroelectric Curie temperature T_C decreases with increasing x. Moreover, the crystal with x = 0.1 has a large dielectric constant of $\varepsilon' = 1200$ and has a large piezoelectric constant of $d_{33} = 300 \text{ pC N}^{-1}$ at room temperature. On the other hand, in barium dititanate ($BaTi_2O_5$) single crystals, a spontaneous polarization of $7 \,\mu\text{C cm}^{-2}$ has been observed at room temperature. The ε' measured at 1 MHz reaches very large value of approximately 30000 at the ferroelectric Curie temperature of $T_C = 750 \text{ K}$, while the dielectric loss tan δ remains small at values below 0.1 at around T_C . These dielectric, thermal and structural properties of the single crystals are described in detail.

1. はじめに

チタン酸バリウムBaTiO₃は強誘電体の代表的物質であり、 コンデンサー材料,圧電材料,電気光学結晶などとして広く 産業界で利用されている。このペロブスカイト構造のチタン 酸バリウムは, T_{C} =400K付近で強誘電相転移を起こし、立 方晶から室温の正方晶へと結晶構造が変化する。BaTiO₃に は多形として六方晶の結晶も存在する。立方晶BaTiO₃では、 頂点を共有したTiO₆酸素八面体の連結で三次元構造の骨格 が作られているのに対して、六方晶BaTiO₃では面を共有し た酸素八面体も存在する。六方晶BaTiO₃においても、低温 の T_{C} =74K以下で、強誘電性が六方晶のc-軸方向に出現す る。^{1,2)}

六方晶と立方晶の両チタン酸バリウムの物性を比較しよう とした時に,強誘電体の代表的物質である立方晶チタン酸バ リウムに関して膨大な論文が発表されているにもかかわらず, 低温物性に関してはデータが極端に少ないことに気づいた。

低温では、複雑なドメインが入ることや応用的関心が低いこ とがデータの少なさの原因と思われる。高純度チタン酸バリ ウム単結晶が育成され、3)光学結晶として市販されている昨 今であるので、低温での立方晶チタン酸バリウムの強誘電特 性を調べ直そうと実験を開始した。初期的研究から、トップ シード法 (Top Seeded Solution Growth, TSSG) で育成さ れた単結晶(Linz 結晶とも呼ばれる)には、低温の100 K付 近にダイポールグラス転移があることが分かった。4.5) また, 最も重要な強誘電転移温度Tcが、フッ化カリウム(KF)を フラックスにして育成した単結晶(Remeika結晶とも呼ばれ る) では高々390 K程度であるのに対し, TSSG 結晶では 400 K以上でばらつくなど腑に落ちない点が見えてきた。の KFフラックス法ではフラックスのカリウムやフッ素が混入 するため転移温度が下がると言われているが、どの程度物性 や転移温度に影響するのか詳しく調べられていなかった。ま た、TSSG結晶はTiOっリッチ溶液からの育成であるので、チ タンリッチな結晶 (Ba 欠損結晶) ができている可能性もあ

© 2006 The Japan Society of Calorimetry and Thermal Analysis. 160 Netsu Sokutei 33 (4) 2006



Fig.1 Temperature dependence of the dielectric constant ε' and the dielectric loss tanδ on a BaTiO₃ single crystal grown by a self-flux method. The electric field E is along the cubic [100] direction; measurement frequencies at temperatures above 300 K are ■: 75 kHz, ◆: 300 kHz, ●: 1000 kHz.

る。これらのことを明らかにするには、同じ条件で育成した 結晶について、その組成を評価し、物性を調べることが重要 であると判断した。

上記の点を考慮しつつ,著者は,Ba-Ti 系酸化物の単結晶 を育成し,その物性を明らかにしていく地道な研究を開始し た。そうした中,KF添加の単結晶 (Ba_{1-x}K_xTiO_{3-x}F_x)に おいて,x=0.1の時,室温での圧電定数 d_{33} が300 pC N⁻¹ と大きな値を持つことを見出した。70 また,BaTiO₃とは組成 の異なるBaTi₂O₅単結晶において,誘電率が30000にも達す る強誘電相転移が750 K付近で出現することを見出した。⁸⁻¹⁰⁾応用的にも興味深く思われるので,BaTiO₃と比較しつつ, これら新規チタン酸バリウム系強誘電体の物性を紹介したい。

2. BaTiO3単結晶の誘電特性

有名なRaseとRoy¹¹⁾のBaO-TiO₂系相図からわかるよう に,BaOとTiO₂を1:1に混ぜ合わせ,調和溶融条件で育成 すると,高温安定相の六方晶チタン酸バリウムができてしま う。立方晶チタン酸バリウム単結を得るためには,立方晶-六方晶転移が起こる1733 K以下の温度での育成が必須であ り,フッ化カリウム(KF)などの溶剤を用いるか,酸化チ タンを過剰にした溶液からの育成が行われている(セルフフ ラックス法)。市販のTSSG結晶は,TiO₂が約65%のチタン リッチ溶液からの育成である。

Fig.1に、セルフフラックス法で育成した立方晶チタン酸 バリウムの(100)板の誘電特性を示す。¹⁰⁾ 温度の上昇に伴い、 200 K, 280 K, 400 K付近で相転移を起こし、結晶系が菱 面体→斜方晶→正方晶→立方晶へと変化する。各相転移点で 1次転移特有の鋭い飛びが見られる。また,600 K以上の高 温では,誘電損 $tan\delta$ が増大するため,誘電率も見かけ上大 きくなっている。

低温での誘電特性を詳しく見ると、菱面体相内の100 K 付近に誘電率が1000から2000に達するブロードな山があ り、周波数の増加とともに山の温度は高温側に移動する。 この緩和型の低温誘電異常は、次のような主に三つの性質 を持つ。4.5) ① KFフラックス法で育成した純度の悪い結晶 には見られず、TSSG 結晶やセルフフラックス法で育成し た純度の良い結晶に見られる。4) ② 電場中冷却処理(ポー リング)によって、(100)板では分散が消失するのに対し、 (111) 板では逆に分散が鋭く大きくなる。すなわち、菱面 体相の(111)方向に電場をかけ単分域にした試料の方が分 散は大きくなる。5) このことから推察すると、低温分散の起 源を強誘電分域壁の運動とするには無理がある。③ 測定周 波数 fの対数と誘電損 $tan\delta$ がピークとなる温度 T_{max} の逆数 との関係 (log f 対 $1/T_{max}$) は、単純な活性化型というより Vogel-Fulcher 則, $f=f_{o} \exp[-E/(T_{max}-T_{o})]$, の方がよく フィットできる。また,誘電分散への静水圧pの効果を調 べると、5) 圧力pが60, 120, 150 MPaへと増加するにつれ て、凍結温度T。は74 K, 78 K, 82 Kと上昇する。このT。 の圧力依存は、ガラス転移などで見られる傾向と同じであ る。Baなどの格子欠陥に起因した何らかの局所双極子が存 在し、その運動がT。で凍結し、ダイポールグラス状態とな る時に、低温誘電分散が現れると考えられる。

3. BaTiO₃単結晶の相転移温度 T_C

チタン酸バリウム単結晶を育成するもう一つの方法である フッ化カリウム (KF) を溶剤 (フラックス) とした単結晶 育成を行い, KFの混入の影響について調べてみた。の BaO, TiO₂, KFの仕込み量を変えることで, KF添加量の異なる 単結晶 (Ba_{1-x}K_xTiO_{3-x}F_x) を作製した。組成はEPMA で 分析した。BaOとTiO₂を1:1に仕込んだ場合でも溶剤のKF がx=0.01程度混入する。更に1:2では, x=0.1と大量の KFが混入することが分かった。⑦ 溶液中にBaが不足すると, 溶剤のKFがBaTiO₃結晶中に混入しやすくなるのであろう。

Fig.2に、組成が $x = 0.01 \ge x = 0.1$ の単結晶の [100] 方 向の誘電率の温度依存を示す。組成x = 0.1の単結晶では、転 移温度 $T_{\rm C}$ が35℃まで低下し、室温付近での誘電率が、12000 近くにまで大きくなる。⁷⁾ 一方、誘電損失 $\tan\delta$ は0.01 程度と 小さくコンデンサーとしては有望である。転移をブロード化 してリラクサーにできれば応用の可能性が更に広がる。圧電 定数 d_{33} も20℃で300 pC N⁻¹と大きく、BaTiO₃の5倍、市 販されているPZT の1.5倍くらいの大きさである。

KF添加単結晶の転移温度 T_c とEPMAで分析したK濃度の平均値xとの関係をFig.3に黒丸で示す。6ばらつきが大きいが、Kイオンの混入に従って転移温度が低下していくこと



Fig.2 Temperature dependence of the dielectric constant on $Ba_{1-x}K_xTiO_{3-x}F_x$ single crystals with x =0.01 and x = 0.1. The electric field E is along the cubic [100] direction; the measurement frequency is 300 Hz.



Fig.3 Relation of the Curie temperature T_C and the concentration of K ions in $Ba_{1-x}K_x TiO_{3-x}F_x$ single crystals grown by a KF flux method (\oplus). T_C for single crystals grown by a TSSG method are also shown by plots (\Box) at x=0.

が分かる。Kイオンの濃度ゼロまで直線近似で外挿して求め たTcは400Kである。同じグラフ上に,TSSG法で育成され た単結晶試料のTcをx=0のところにプロットすると,402 Kから408K付近でばらついている。なぜ,外挿点である 400Kでなく,400Kより高い温度でばらつくのか疑問であ る。TSSG結晶には転移温度を左右する別のパラメータが隠 されているように見える。従来,転移温度の高い試料は良質 といわれてきた。今回のKFフラックス結晶の結果が示すよ うに,Kイオンの混入は確かに転移温度の低下をもたらすの で,KFフラックス結晶においては,転移温度の高い試料の 方がKの混入の少ない結晶と言える。しかし,TSSG法の結



Fig.4 Phase diagram of the BaO-TiO₂ system (Ritter *et al.*, 1986). The numbers of 1:1, 1:2, 6:17, 4:13, 1:4, 2:9 and 1:5 in the figure represent BaTiO₃, BaTi₂O₅, Ba₆Ti₁₇O₄₀, Ba₄Ti₁₃O₃₀, BaTi₄O₉, Ba₂Ti₉O₂₀ and BaTi₅O₁₁, respectively.

晶では、純度と関係ないところで*T*cの上昇がありそうに見 える。

4. 新規強誘電体BaTi₂O₅の発見

BaTi₂O₅単結晶は1951年のStattonの論文¹²⁾に登場する。 彼は、TiO₂が68%の組成で溶融し急冷することで、BaTi₂O₅ の針状結晶を得ている。RaseとRoy11)による相図では、BaO とTiO₂の1対2組成のところに、BaTi₂O₅が高温の1595 K まで安定して存在している。しかし、その後の研究により、 BaTi₂O₅は約1423 K以上で別の物質に分解することが明ら かにされた。Fig.4 に、1986年にRitter ら13)によって決めら れたBaO-TiO2系相図を示す。この相図からも分かるように、 BaTi₂O₅は1423K以上でBaTiO₃とBa₆Ti₁₇O₄₀に分解し、さ らに高温の1595 K付近で溶解し始める。従って、この相図 を見る限り、1対2組成を溶融しても大きな単結晶を得るこ とは困難のように思われる。我々は, Statton と同じ急冷法 で, Fig.5 に示した1×1×5 mm³程度のb軸に長い針状結晶 を得た。9,10)時を同じくして、東北大の後藤グループ14)から は、フローティングゾーン (FZ) 炉を用いて、棒状多結晶 が育成され、誘電率などの物性測定がなされた。1対2組成 から, FZ 炉で単結晶が育成できるとなると, Fig.4 の1 対2 組成付近の相図は、雰囲気などの微妙な違いで変化するのか もしれない。相図については、今後、更なる研究の発展が望 まれる。



Fig.5 Photograph of $BaTi_2O_5$ single crystals: needlelike shape and long along the *b*-axis. The dimension is approximately $1 \times 1 \times 5$ mm³.



Fig.6 Crystal structure of BaTi₂O₅. There are 3 kinds of oxygen octahedra (Ti1O₆, Ti2O₆, Ti3O₆) and 2 kinds of Ba ion (Ba1, Ba2). Three octahedra connect each other with their apexes and edges.

BaTi₂O₅の結晶構造は1956年にHarrison¹⁵⁾によって調べ られており,室温で、単斜晶 (a = 16.892 Å, b = 3.930 Å, c = 9.410 Å, $\beta = 103.03^{\circ}$),空間群 C2/m と求められてい る。中心対称性のある空間群であり,強誘電性は現れないは ずであった。Fig.6 に、BaTi₂O₅の結晶構造を示す。2種類の Baイオン (Bal, Ba2) と3種類の酸素八面体 (Ti1O₆, Ti2O₆, Ti3O₆) から構成され,それぞれの酸素八面体は頂点及び稜 で連結している。Ti1O₆, Ti2O₆, Ti3O₆は,それぞれ1個, 6個,3個の稜共有を持つ。酸素八面体の頂点共有からだけ から成るABO₃ペロブスカイト構造と比較すると、やや複雑 である。ペロブスカイト構造の単位胞の大きさを $a_0(\sim 4$ Å) とすると、BaTi₂O₅の単位胞は、おおよそ $a \sim \sqrt{17} a_0, b \sim a_0,$ $c \sim \sqrt{5} a_0$ の大きさであり、それぞれペロブスカイト構造の [140], [001], [210] 方向に対応する。この単位胞にBaTi₂O₅

この単結晶の誘電特性を詳細に調べたところ, Fig.7 に示



Fig.7 Temperature dependence of the dielectric constant ε' and the dielectric loss tanδ on a BaTi₂O₅ single crystal. The electric field E is along the b-axis; measurement frequencies are ■: 75 kHz, ◆: 300 kH, ●: 1000 kHz. Inset shows the D-E hysteresis loop at room temperature.

すように、750 K付近にb軸方向の誘電率が30000にも達す る大きな誘電異常を見出した。 9,10 この誘電率の大きさは、 BaTiO₃が T_c で10000 ぐらいであるのと比較すると(Fig.1)、 3倍近く大きい。室温でのDE履歴曲線の測定から、b軸方向 に約7 μ C cm $^{-2}$ の自発分極を持つ強誘電体であることが分か った(Fig.7)。 90 この自発分極の大きさは、BaTiO₃の約3分の 1程度と小さい。分極がb軸方向に現れることから、室温で の結晶構造は、中心対称性のない空間群C2と変更された。 90 一方、誘電損失tan δ は、高温の600~900 K付近でも0.1以 下と小さく(Fig.7)、600 K以上でtan δ が発散的に大きくな る BaTiO₃とは大違いである(Fig.1)。従って、BaTi₂O₅は 高温用のコンデンサーなどの電子材料としても有望である。

単結晶を用いた光散乱実験が,Hushurら^{16,17)}によって行われ,T_c付近でセントラルモードの増大が見られることや ソフトモードが見出されなかったことから,この相転移のメ カニズムが,変位型というより秩序・無秩序型に近いことが 指摘された。また,Waghmareら¹⁸⁾は,第一原理計算によっ てBaTi₂O₅の圧電定数の値を計算し,その値がPbTiO₃と同 程度であることを明らかにした。従って,BaTi₂O₅は,高温 用コンデンサー材料ばかりでなく,鉛フリーな圧電材料とし ても有望である。

5. BaTi₂O₅の結晶構造と相転移

強誘電性の起源を調べる目的で、単結晶X線回折による 室温での結晶構造解析がなされた。^{19,20} Harrisonの空間群 C2/mを出発点として、b軸方向に自発分極の発生する空間 群C2への変更に伴う、構造の最適化である。Fig.8に、 Kimuraら¹⁹によって求められた構造解析の結果を示す。詳 しくは、この論文を見てもらうとして、強誘電性の発生にか



Fig.8 Crystal structure of BaTi₂O₅ (Kimura et al., 2003).



Fig.9 Temperature dependence of the bond lengths of Ti1-O1, Ti2-O5 and Ti3-O4 in three kinds of TiO₆ octahedra.

かわる特徴的な部分だけを記述する。中心対称のある空間群 C2/mでは、原子は、配位座標 (x, y, z) のy=0または1/2 に 位置するが、b軸方向に極性をもつ空間群C2では、原子は y=0または1/2から僅かにずれてくる。Balのy座標を基準 にすると (y=0.000とする)、Ba2はy=+0.002、Ti2は+ 0.012、Ti3は+0.009、酸素のO1~O8は+0.009~+0.021 と全て正方向に変位している。これに対して、Ti1だけが反 対の負方向に-0.031だけ変位する。従って、Ti2-O5のボン ド長が2.025 Åと2.028 Å、Ti3-O4のボンド長が1.983 Åと 2.018 Åとほぼ等しいのに対して、Ti1-O1のボンド長は1.765 Åと2.171 Åと極端に違っている。このTi1O₆の変位の仕方 は、BaTiO₃の強誘電性を導くスレーターモード(チタンと 配位酸素の反位相変位)と同じである。

高温相 $(T > T_c)$ での粉末中性子回折実験により,高温相 の原子座標が,中心対称のない空間群C2/mとして,求めら れた。²¹⁾ また,強誘電相においても高精度の粉末中性子回折 実験が行われ,三種の酸素八面体のボンド長の温度変化が調 べられた。²²⁾ Fig.9 に示すように,Ti1-O1のボンド長がTi2-O5 やTi3-O4のボンド長に比べ大きく変化している。従って, 三つあるTiO₆酸素八面体の内,Ti1O₆の格子変位がこの物 質の強誘電性を主に担っているようである。このことは,自 発分極がBaTiO₃と比べて3分の1程度の大きさであること



Fig.10 Temperature dependence of the unite-cell volume of $BaTi_2O_5$; \bigoplus : on heating, \Box : on cooling.

とも対応しそうである。

6. BaTi₂O₅の相転移における熱異常

単位胞の体積Vの温度依存をFig.10に示す。20)これは、単 結晶試料の粉末X線回折パターンからリートベルト法で格子 定数を求め、それから導いた単位胞の体積である。Tc=750 K付近の相転移に対応して、僅かな変化が見られる。体積膨 張率は、Tc以下の500 K で34.0×10-6 K-1、Tc以上の900 Kで17.3×10-6 K-1と求まる。それぞれの直線を外挿する と、 $T_{\rm C}$ で $\Delta V/V = 0.16$ %の飛びが見られる。BaTiO₃の $T_{\rm C}$ で の体積変化がΔV/V=-0.06%であったことを考えると、符 号が逆である。BaTiO3では、常誘電相から強誘電相へ移る 時に体積が僅かに増加したの対して、BaTi2O5では体積が減 少している。一次転移における Clausius-Clapeyron の関係 $dp/dT_{\rm C} = \Delta H/T_{\rm C} \Delta V$ からも、二次転移におけるEhrenfestの関 係 $dp/dT_{c} = \Delta C_{p}/T_{c}V\Delta\beta$ からも言えることであるが、今回の 体積の飛び ΔV や熱膨張率の飛び $\Delta \beta$ の符号から判断すると, BaTi₂O₅の場合,転移温度の圧力係数 dT_c/dp は正となる。 Samara²³⁾の強誘電相転移に関する圧力効果の経験則に従う と、dTc/dpの符号は、BaTiO3のような変位型では負であり、 NaNOっのような秩序・無秩序転移では正となる。従って、転 移点付近での体積膨張の振る舞いは、二つのチタン酸バリウ ムにおける強誘電相転移のメカニズムの違いを示唆している ように思える。

AC カロリメーター(真空理工ACC-1,300 K < T < 800 K) と緩和型比熱測定装置(カンタムデザイン社 PPMS,2 K < T < 300 K)を用いて比熱の温度依存性を広い温度域に 渡って測定した。Fig.11 に,FZ 法で育成した単結晶試料の 比熱の温度依存性を示す。²⁴ AC 法では比熱の相対的な温度 による変化を精度良く求めることはできるが,絶対値は求め られない。Fig.11 のデータは,300 K から800 K の温度域に



Fig.11 Specific heat C_p of BaTi₂O₅ single crystals, which were grown by a FZ method.

おいて示差走査熱量測定 (DSC: Differential Scanning Calorimetry) で求めた比熱値に合うように、補正してある。

今回用いた補正法を紹介するため比熱の生データを**Fig.12** に示しておく。AC法で得られた比熱値を300 K でのDSC で の比熱値と合わせ,全温度域(300~800 K)で比熱値を比 較すると,高温になるに従って,AC法の比熱値が大きくな っていることが分かる。AC法においては,高温になるにつ れて試料からの輻射が大きくなり,試料に加えた熱が加熱中 および加熱直後に試料から外部に逃げてしまい,比熱値を実 際より大きくしている可能性がある。そこで,AC法による 比熱値 C_p から温度に比例した一定量を差し引く補正法を試 み, $C_p'(T) = C_p(T) - a(T - 300 K), 800 K でのDSC の比熱$ $値<math>C_p'$ と一致するように温度比例係数aを求めた。**Fig.12**に 示すように,補正後のAC法比熱はDSC の比熱値をほぼ全 温度域で良く再現している。

誘電率がピークとなる温度の $T_{\rm C} = 726$ Kで,比熱にも入型 の熱異常が現れることが分かった(Fig.11)。ベースライン を近似して,転移エンタルピー $\Delta H = 80$ J mol⁻¹と転移エン トロピー $\Delta S = 0.11$ J mol⁻¹ K⁻¹を求めた。転移エントロピ ーの値は,熱力学の基本式、 $\Delta S = 2\pi P_S^2 C^{-1}$ により、自発 分極 P_S とキュリー定数Cとから大雑把に見積もることがで きる。BaTi₂O₅単結晶での値 $P_S = 7 \mu$ C cm⁻² と $C = 1.8 \times 10^5$ Kを代入すると、転移エントロピー ΔS は0.094 J mol⁻¹ K⁻¹ になるので、今回の比熱測定から求めた結果とほぼ一致する。 このBaTi₂O₅の転移エントロピーの値は、BaTiO₃が $\Delta S =$ 0.52 J mol⁻¹ K⁻¹であることと比較して、かなり小さい。こ の小ささは、自発分極 P_S の値がBaTiO₃で25 μ C cm⁻²であ るのに対してBaTi₂O₅では約7 μ C cm⁻² と小さいことに対応 していると思われる。

Ti1 イオンだけが相転移に寄与する秩序・無秩序転移を仮 定して転移エントロピーを求めると、ΔS = (2/3)R ln 2 となり、



Fig.12 Specific heat C_p of BaTi₂O₅ single crystals, measured using an AC calorimeter and a DSC. The C_p data for the AC calorimeter were corrected with an equation of $C_p = C_p - 0.019 \times (T - 300 \text{ K})$.



Fig.13 Temperature dependence of the dielectric constants on three Ba-Ti oxides ferroelectrics: hexagonal BaTiO₃, cubic BaTiO₃ and BaTi₂O₅.

3.84 J mol⁻¹ K⁻¹と計算できる。²⁴⁾ この値は,実験値の0.11 J mol⁻¹ K⁻¹と比べて一桁以上大きい。AC カロリメーター では,一次転移における潜熱に対応した熱異常を正確に求め ることができないので,熱異常が小さく出ているのかもしれ ない。相転移の機構解明のために,更なる研究の積み重ねが 望まれる。

7. おわりに

今回見出されたBaTi₂O₅を含むチタン酸バリウム系強誘電 体 (六方晶BaTiO₃,立方晶BaTiO₃,BaTi₂O₅)の自発分極 軸方向の誘電率の温度依存性をFig.13に、まとめて示して おく。転移温度 $T_{\rm C}$ の上昇と共に(74 K,400 K,750 Kと 変化する), $T_{\rm C}$ での誘電率の最大値が大きくなっていくこと が分かる。

すでに多くの論文があり、わかりきった物質のように思わ

れがちなチタン酸バリウムであるが、結晶育成法の違いと転移温度の関係一つをとっても、未知なる何かが隠されている気がする。TSSG結晶にはストイキオメトリーからのずれがあり、それが低温誘電分散やTc上昇の原因であるのかもしれない。

Ba-Ti系酸化物強誘電体に、六方晶BaTiO₃、立方晶BaTiO₃ に加え、酸素八面体の連結の仕方に稜共有を持つ第三の物質 BaTi₂O₅が新たに加わった。今後、結晶構造を詳しく吟味し、 チタンや酸素の電子状態と転移温度との関係など調べていく ことは、興味深い。また、応用的にも、新規鉛フリー圧電物 質としての可能性があり、セラミックスや薄膜の作製法を開 発できれば更なる研究の発展が期待できる。

謝 辞

本研究を遂行するにあたり,X線回折では,島根大重松宏 武助教授と関西学院大高橋功教授。光散乱実験では筑波大学 小島誠治教授,比熱測定では東工大応用セラミックス研究所 の阿竹 徹教授に大変お世話になりました。村田学術振興財 団,中国電力技術研究財団からは,寄付金を頂きました。感 謝いたします。

文 献

- E. Sawaguchi, Y. Akishige, and M. Kobayashi, J. Phys. Soc. Jpn. 54, 480 (1985).
- 秋重幸邦,小林正和,沢口悦郎,固体物理 21,31 (1986);秋重幸邦,固体物理 26,471 (1991).
- S. Ajimura, K. Tomomatsu, O. Nakao, A. Kurosaka, H. Tominaga, and O. Fukuda, J. Opt. Soc. Am. B9, 1609 (1992).
- Y. Akishige, T. Nakanishi, and N. Mori, Ferroelectrics 217, 217 (1998); 秋重幸邦, 固体物理 35, 713 (2000).
- Y. Akishige and N. Mori, J. Korean Phys. Soc. 35, S1441 (1999).
- Y. Akishige, T. Michiie, and T.Tsunogae, Ferroelectrics 269, 249 (2002).
- 7) Y.Akishige, J. Phys. Soc. Jpn. 75, 073704 (2006).
- 深野勝洋,重松宏武,松本一郎,秋重幸邦,日本物理学 会講演概要集57, No.2, Part 4, 816 (2002).
- Y. Akishige, K. Fukano, and H. Shigematsu, Jpn. J. Appl. Phys., Part 2 42, L946 (2003).
- Y. Akishige, K. Fukano, and H. Shigematsu, J. Electroceramics 13, 561 (2004).
- D. E. Rase and R. Roy, J. Am. Ceram. Soc. 38, 102 (1955): 日本結晶成長学会編「結晶成長ハンドブ ック」共立出版, 481 (1995).
- 12) W. O. Statton, J. Chem. Phys. 19, 33 (1951).

- 13) J. J. Ritter, R. S. Roth, and J. E. Blendell, J. Am. Ceram. Soc. 69, 155 (1986).
- 14) T. Akashi, H. Iwata, and T. Goto, *Mater. Trans.* 44, 802 (2003).
- 15) F. W. Harrison, Acta Cryst. 9, 495 (1956).
- 16) A. Hushur, H. Shigematsu, Y. Akishige, and S. Kojima, Jpn. J. Appl. Phys., Part 1 43, 6825 (2004).
- A. Hushur, H. Shigematsu, Y. Akishige, and S. Kojima, *Appl. Phys. Lett.* 86, 112903 (2005).
- 18) U. Waghmare, M. H. F. Sluiter, T. Kimura, T. Goto, and Y. Kawazoe, *Appl. Phys. Lett.* 84, 4917 (2004).
- T. Kimura, T. Goto, H. Yamane, H. Iwata, T. Kajiwara, and T. Akashi, *Acta Cryst.* C59, i128 (2003).
- Y.Akishige, H. Shigematsu, A. Kitahara, and I. Takahashi, J. Korean Phys. Soc. 46, 24 (2005).
- M. Yashima, R. Tu, T. Goto, and H. Yamane, *Appl. Phys. Lett.* 87, 101909 (2005).
- H. Shigematsu, Y. Akishige, S. Gvasaliya, V. Pomjakushin, S. Lushnikov, and S. Kojima, *Ferroelectrics*, in press.
- 23) G. A. Samara, T. Sakudo, and K. Yoshimitsu, *Phys. Rev. Lett.* 35, 1767 (1975).
- 24) Y. Akishige, H. Shigematsu, T. Tojo, H. Kawaji, and T. Akate, *Ferroelectrics* 336, 1 (2006).

要 旨

KF添加のチタン酸バリウム単結晶 ($Ba_{1-x}K_xTiO_{3-x}F_x$) において, x = 0.1のとき,室温での圧電定数 d_{33} が300 pC N⁻¹と大きな値を持つことを見出した。また, $BaTiO_3$ とは 組成の異なる $BaTi_2O_5$ 単結晶において,誘電率が30000にも 達する誘電異常が $T_c = 750$ K付近に存在し,室温で7 μ C cm⁻²の自発分極が出現することを見出した。応用的にも興 味深く思われるので,これら新規チタン酸バリウム系強誘電 体単結晶の誘電的,熱的,構造的特徴を, $BaTiO_3$ の場合と 比較しつつ紹介する。

秋重幸邦 Yukikuni Akishige

島根大学教育学部自然環境教育講座 教授, Dept. of Natural Science Education, Faculty of Education, Shimane Univ., TEL.&FAX. 0852-32-6305, e-mail: akishige@edu.shimane-u.ac.jp

研究テーマ:機能性酸化物の創製と物性研究,低温高圧物 性,物理教材開発 趣味:散歩,読書